

Transmission Electron Microscope Observation of a Single Ni Dot Fabricated Using Scanning Tunneling Microscope

김기범^{1,*}, 김희평², 정우석³, 김민호^{4,1}, 홍철운²

¹전북대학교병원 임상연구소;

²전북대학교 공과대학 헬스케어공학과;

³전북대학교 대학원 의용생체공학과;

⁴전북대학교 의학전문대학원 흉부외과교실

(kgb70@chonbuk.ac.kr*)

In this study, we describe the results of TEM observation of single Ni dot, 100 nm wide and 200 nm high, placed on the top of the bridge on Si-doped GaAs epitaxial layer grown by molecular beam epitaxy(MBE), using a Riber 32 apparatus.